



LINE



焦點新聞

## 諾貝爾物理獎得主天野浩來訪，推動台日先進半導體研究合作



日本諾貝爾物理學獎得主天野浩教授（前排左四）等一行人，與寬能隙化合物半導體中心師生合影

諾貝爾物理學獎得主、名古屋大學電子系的天野浩教授（Amano Hiroshi），上個月來校與師生進行啟發性的學術座談，廣泛交流當前以氮化鎵為主軸的研究成果及對世界永續發展的願景。這次參訪可說是一次針對化合物半導體科技研究領域的深入交流，更意味著雙方對互補有無、攜手合作邁向更遠未來的無限憧憬。

天野浩教授是享譽國際的半導體物理學家，以其在半導體研究領域的卓越貢獻而著稱，也因而在2014年與其博士論文指導老師，同在名古屋大學任教的赤崎勇教授，以及已由日亞化學工業公司轉赴加州大學聖塔芭芭拉分校任教的中村修二教授，共同榮獲諾貝爾物理獎。他的研究成果在用於能發射藍光的半導體材料和裝置方面取得了重大突破，為半導體產業的進步和發展，甚至照明工業，作出卓越貢獻。



天野浩教授（中）由林奇宏校長（右）致贈紀念品，並與張翼院長合影



天野浩教授（中）參觀半導體實驗室



天野浩教授（前排左二）與產創學院師生進行座談

天野浩教授在座談會分享他對未來半導體技術和材料的展望，並鼓勵學生積極參與跨界研究，探索新的科學領域。他強調陽明交大在半導體研究方面的領先地位，並表示希望能與陽明交大攜手推動半導體科技更大的發展。寬能隙化合物半導體中心的師生們也介紹了他們在半導體領域的最新研究成果，並就未來的合作計畫進行了深入討論。

這次座談，為雙方建立深厚的學術聯繫和研究合作打下了堅實基礎，也為本校學生提供了與世界頂尖科學家對話、交流和學習的難得機會，不但為未來的研究合作開啟了大門，從而也擴大了年輕學子們的視野與跨文化學習的機會，也進一步提升陽明交大的影響力。



天野浩教授（左二）參觀寬能隙化合物半導體中心



參訪團與張翼院長（右三）合影



寬能隙化合物半導體中心師生與日本參訪團大合照

寬能隙化合物半導體中心是產創學院針對高頻、高功率、高壓化合物半導體元件，為未來高頻通訊及節能機電關鍵技術，布局未來5G/6G 通訊、電動車及無線充電等熱門應用，以開創新興產業機會而成立。中心延攬多位日籍學者包含名古屋大學Prof. Daisuke Ueda、日本Hitachi執行長Prof. Yohei Otoki、德國FBH機構Hans Joachim Wuerfl交流專業建議，並已派研究生前往日本名古屋大學進行技術學習，未來期許將習得之技術應用於中心，以推動成為世界級頂尖研究中心。

← Prev.    ≡    Next. →

訂閱/取消 上期電子報

發行人：林奇宏 總編輯：陳怡如 執行編輯：彭琬玲  
網頁維護：創創數位科技 瀏覽人數：0742582

Copyright © 2021 National Yang Ming Chiao Tung University All rights reserved